

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753  
 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A114A/J	Rev.	第1版
題名	RX110グループフラッシュメモリのFASR.EXSビットに関するユーザーズマニュアルの誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX110グループ	対象ロット等	関連資料	RX110グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0421JJ0100) RX110グループ 製品仕様の変更について (TN-RX*-A112A/J) RX110グループフラッシュメモリに関するユーザーズマニュアルの誤記訂正 (TN-RX*-A113A/J)	
		全ロット			

RX110グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 の「31. フラッシュメモリ」章において FASR.EXSビットに関する記述に誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

## 〈訂正内容〉

### •Page 845 of 965

「31.3.7 フラッシュ領域選択レジスタ (FASR)」のEXSビットの説明文を以下のとおり訂正いたします。

#### 【訂正前】

FEXCRレジスタを使用したエクストラ領域書き込みを行う場合は“1”にします。  
 エクストラ領域のプログラム時以外は“0”にしてください。

#### 【訂正後】

エクストラ領域に対するソフトウェアコマンド(ユニークIDリード、スタートアップ領域情報プログラム、アクセスウィンドウ情報プログラム)を発行する前に“1”にします。また、ユーザ領域に対するソフトウェアコマンド(プログラム、ブロックイレーズ、ブランクチェック)を発行する前に“0”にします。

ソフトウェアコマンド発行後は、次のソフトウェアコマンドの発行まで値を変更しないでください。

• Page 864 of 965

「31.6.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(3) プログラム/イレーズ方法手順」の図31.7を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

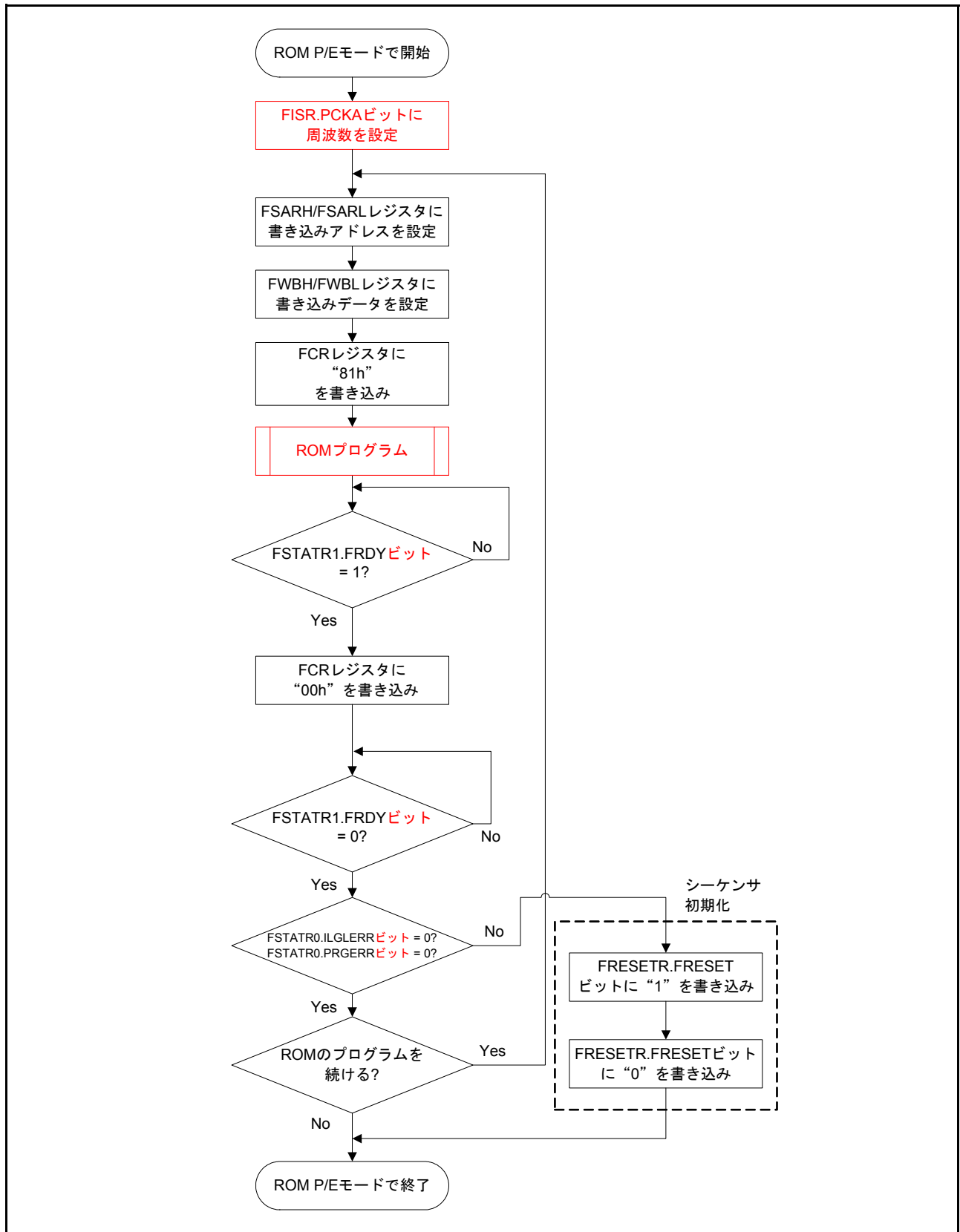


図31.7 プログラム方法手順 (ROM)

【訂正後】

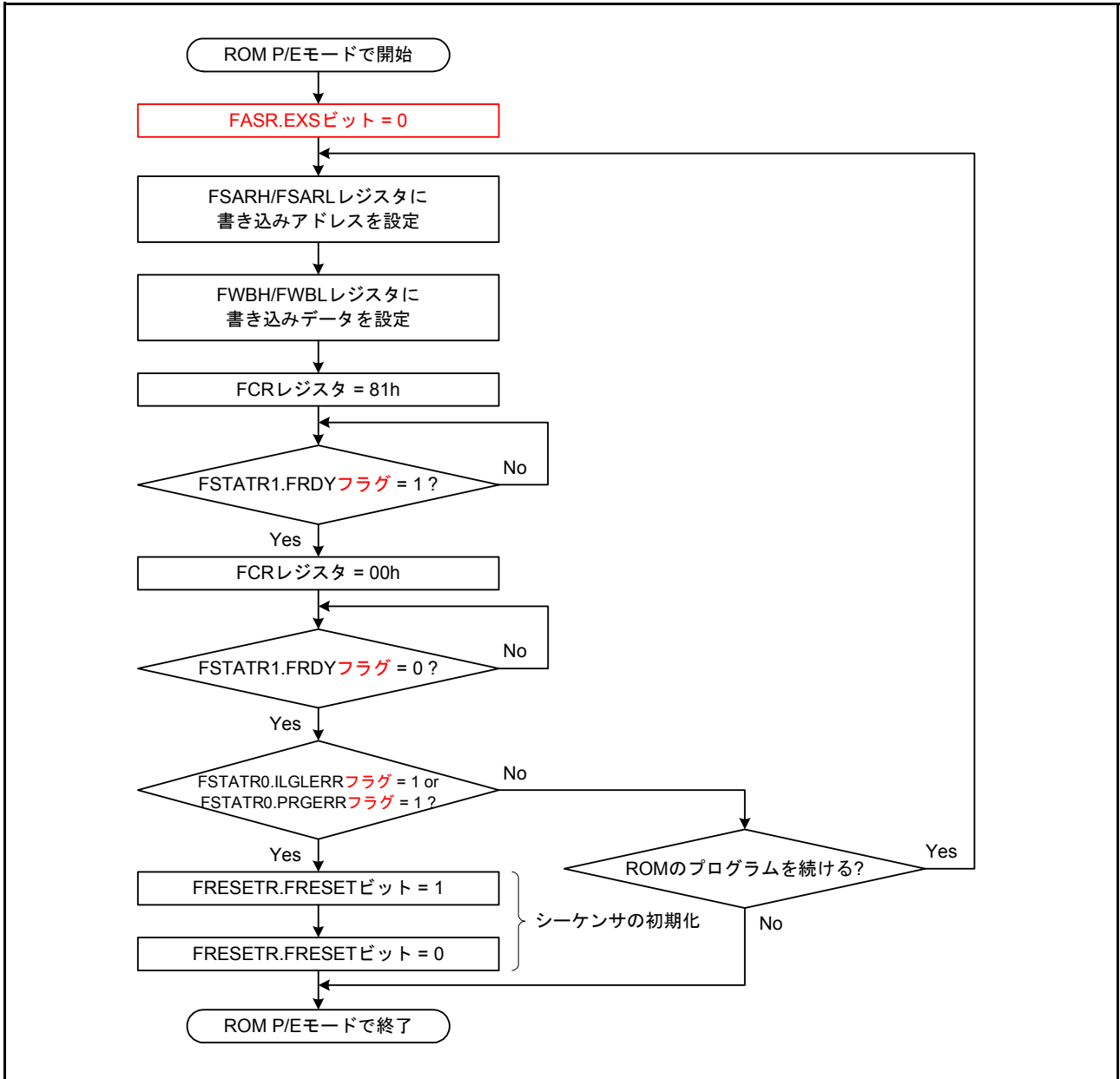


図31.7 プログラムコマンドの発行フロー (ROM)

• Page 865 of 965

「31.6.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(3) プログラム/イレース方法手順」の図31.8を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

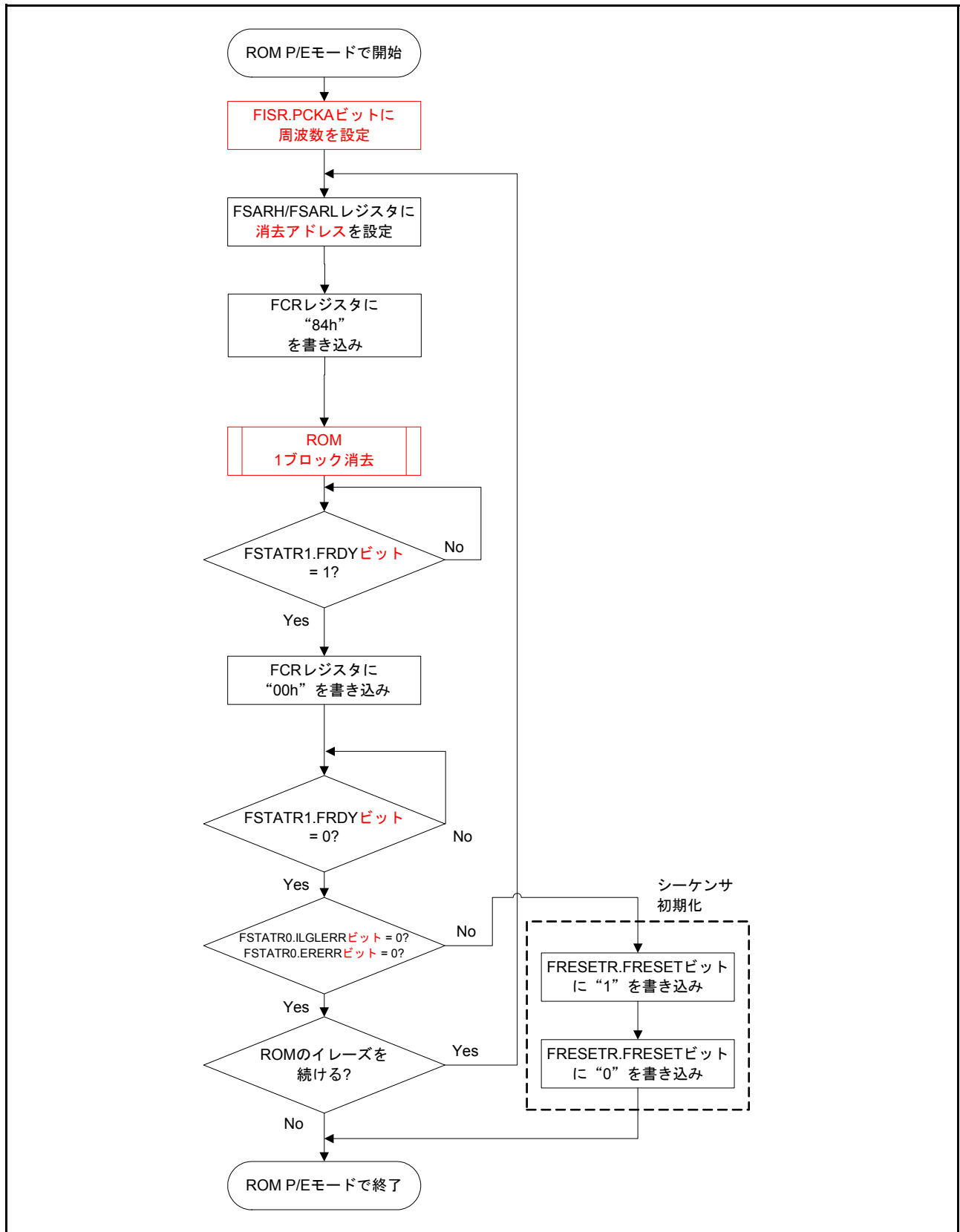


図31.8 ブロックイレース方法手順 (ROM)

【訂正後】

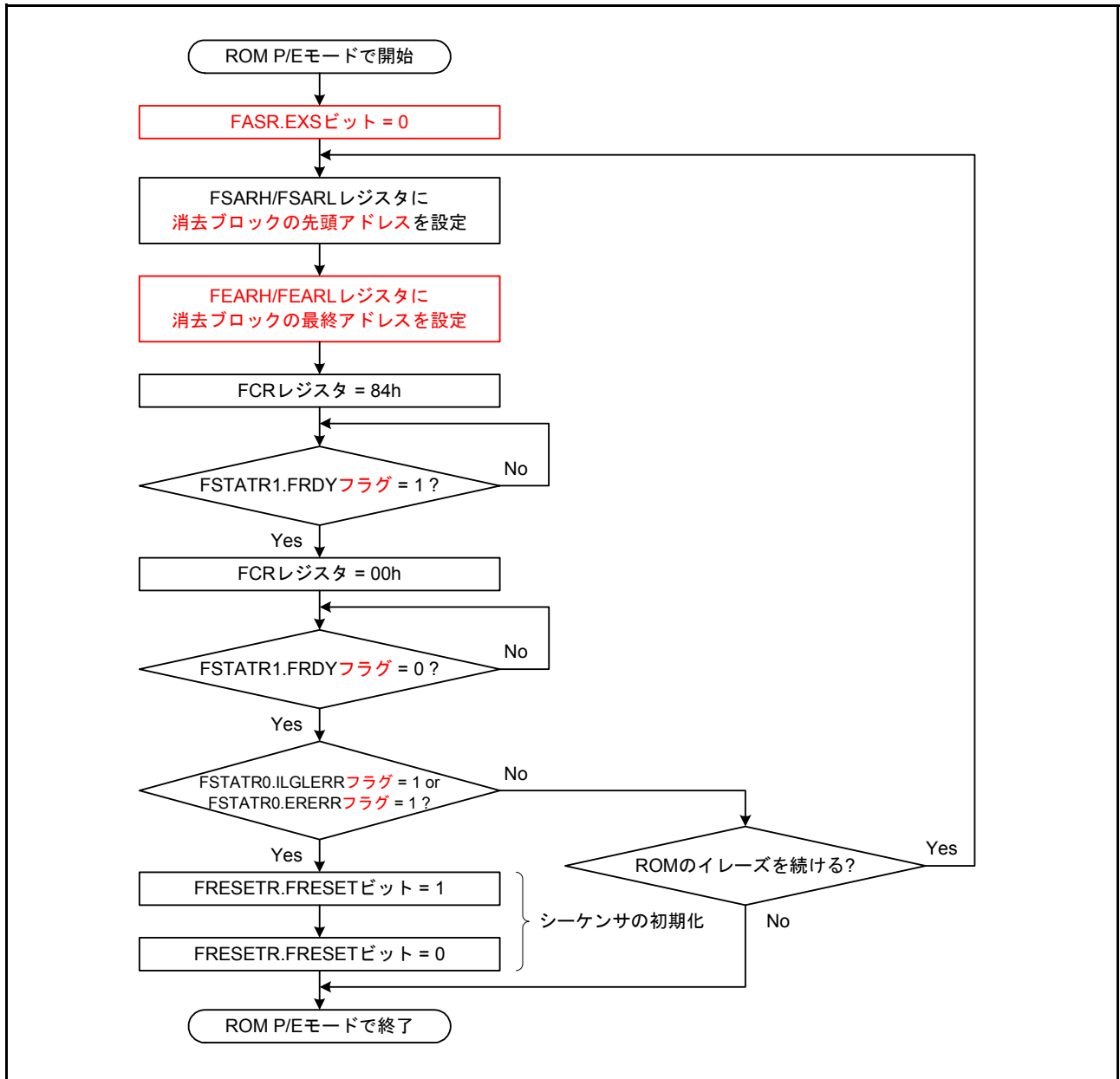


図31.8 ブロックイレースコマンドの発行フロー (ROM)

• Page 866 of 965

「31.6.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(3) プログラム/イレーズ方法手順」の図31.9を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

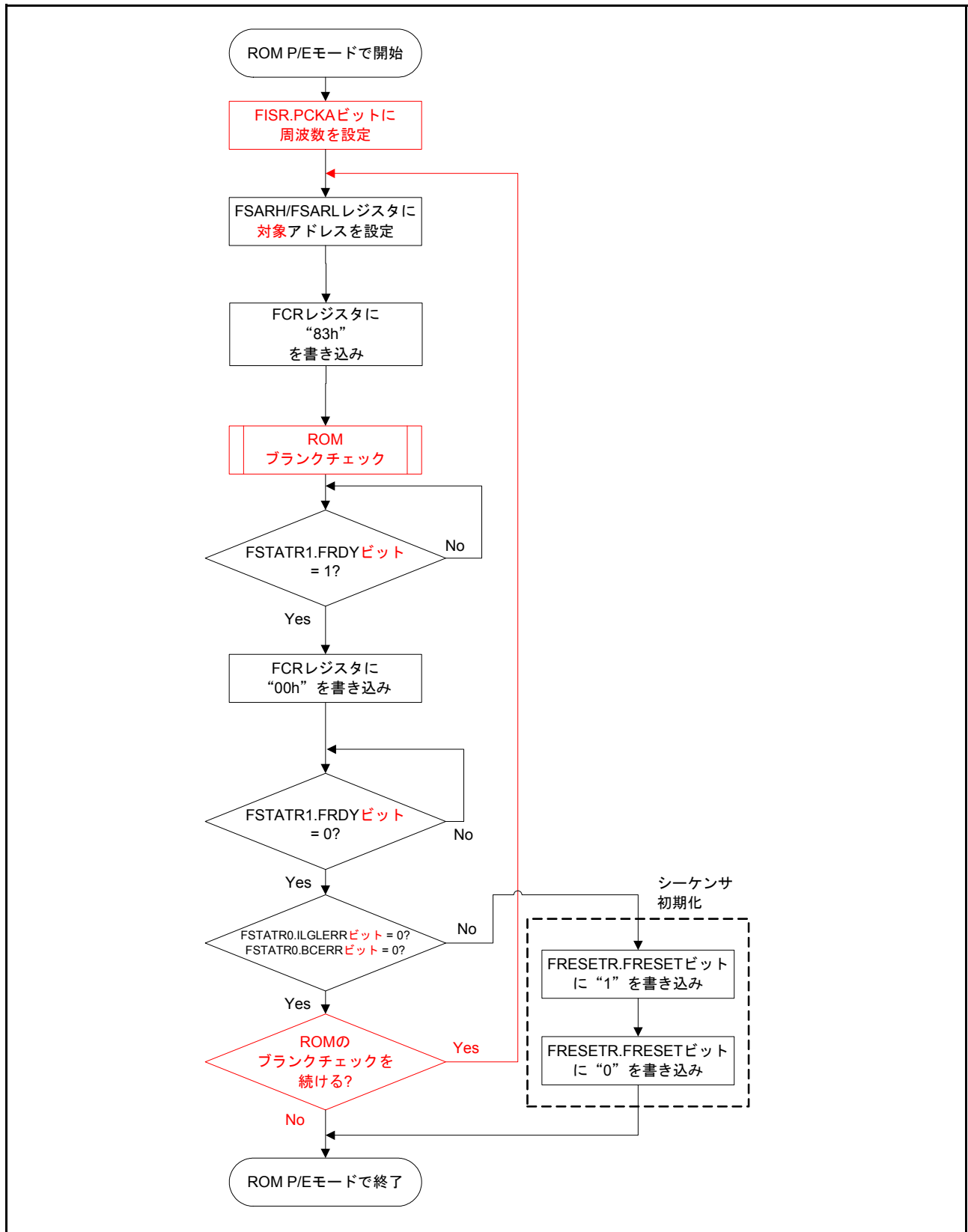


図31.9 ブランクチェック方法手順 (ROM)

【訂正後】

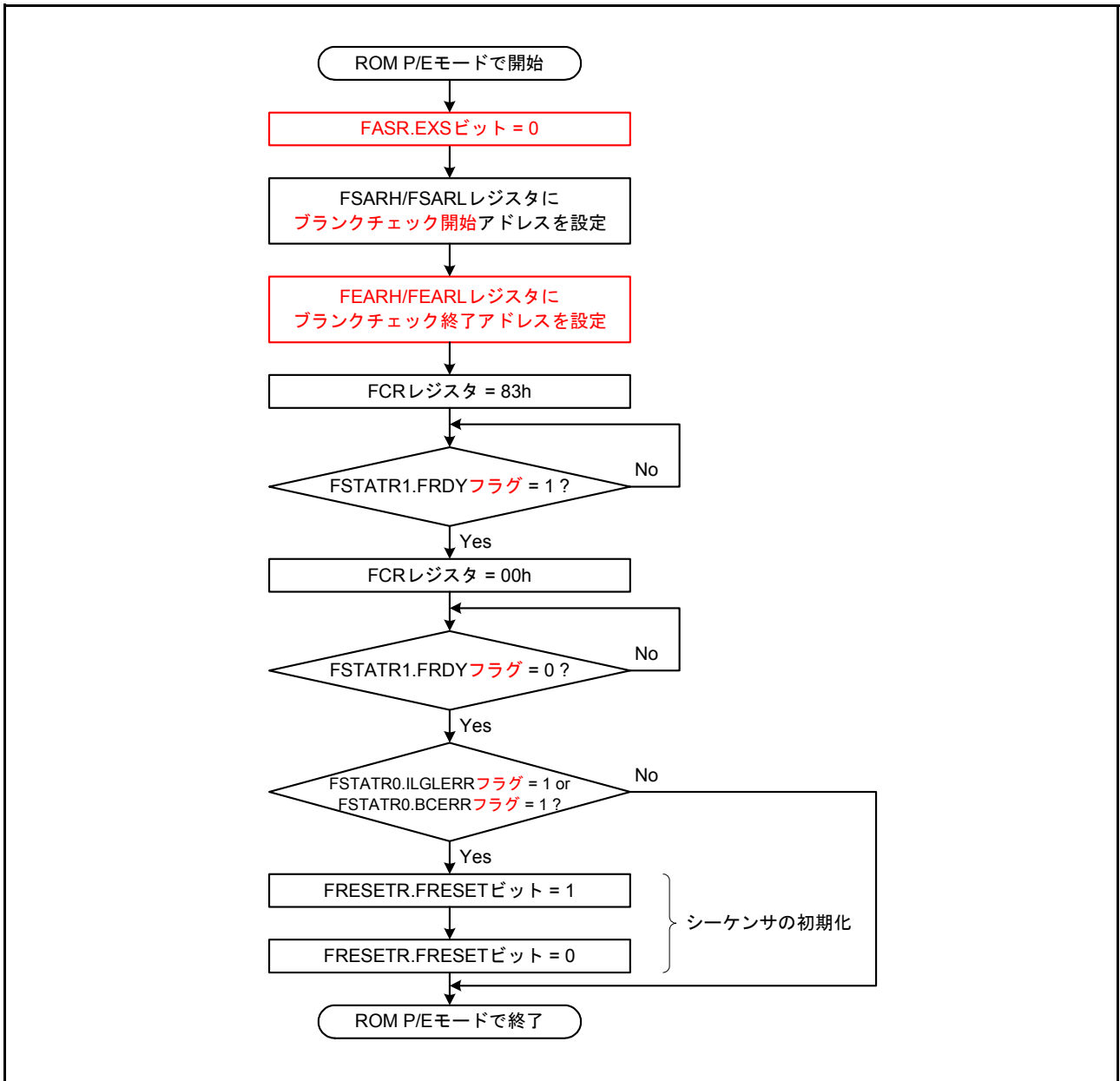


図31.9 ブランクチェックコマンドの発行フロー (ROM)

• Page 867 of 965

「31.6.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(4) スタートアップ領域情報プログラム/アクセスウィンドウ情報プログラム」の図31.10を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

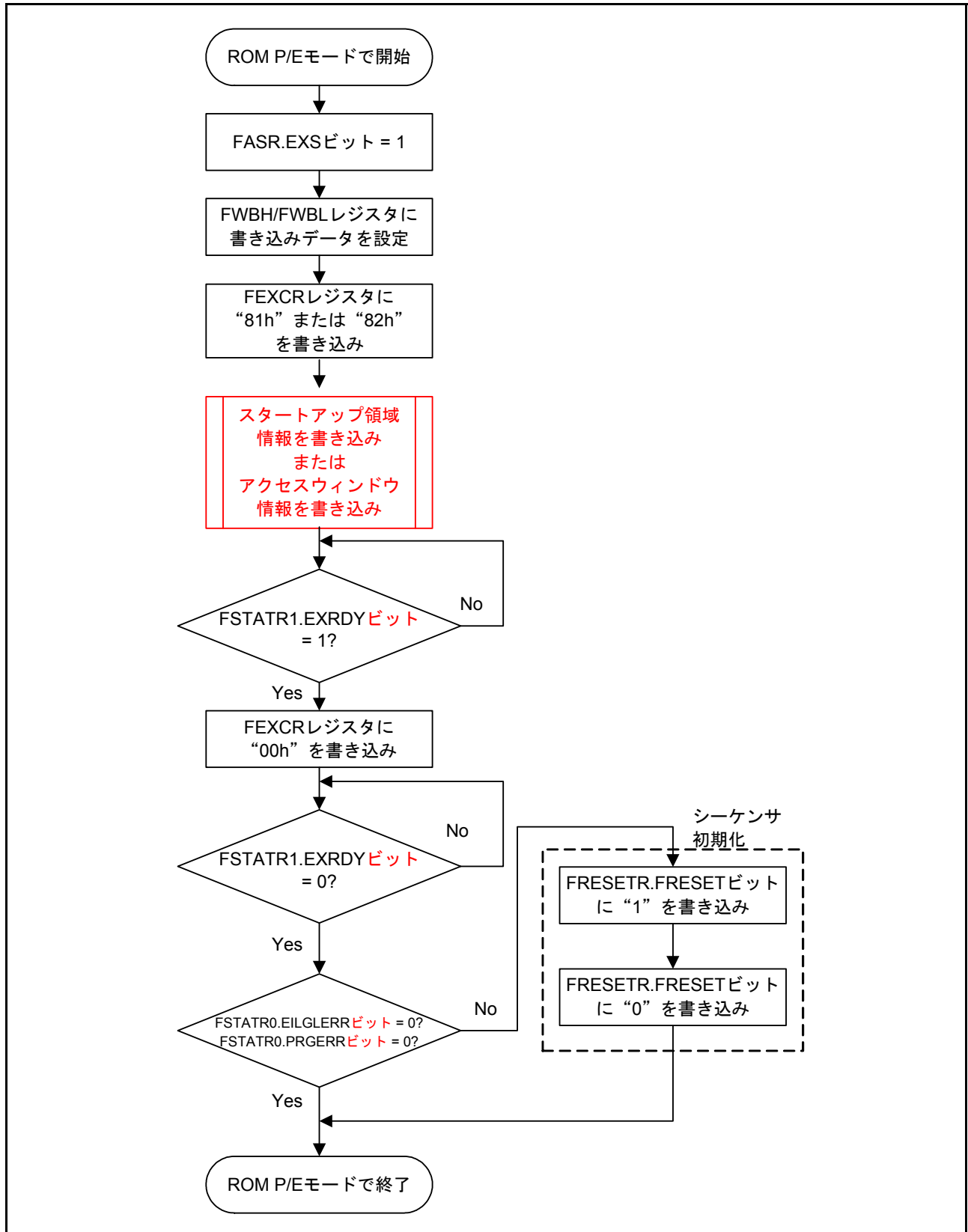


図31.10 スタートアップ領域情報プログラム/アクセスウィンドウ情報プログラムの概略フロー



【訂正後】

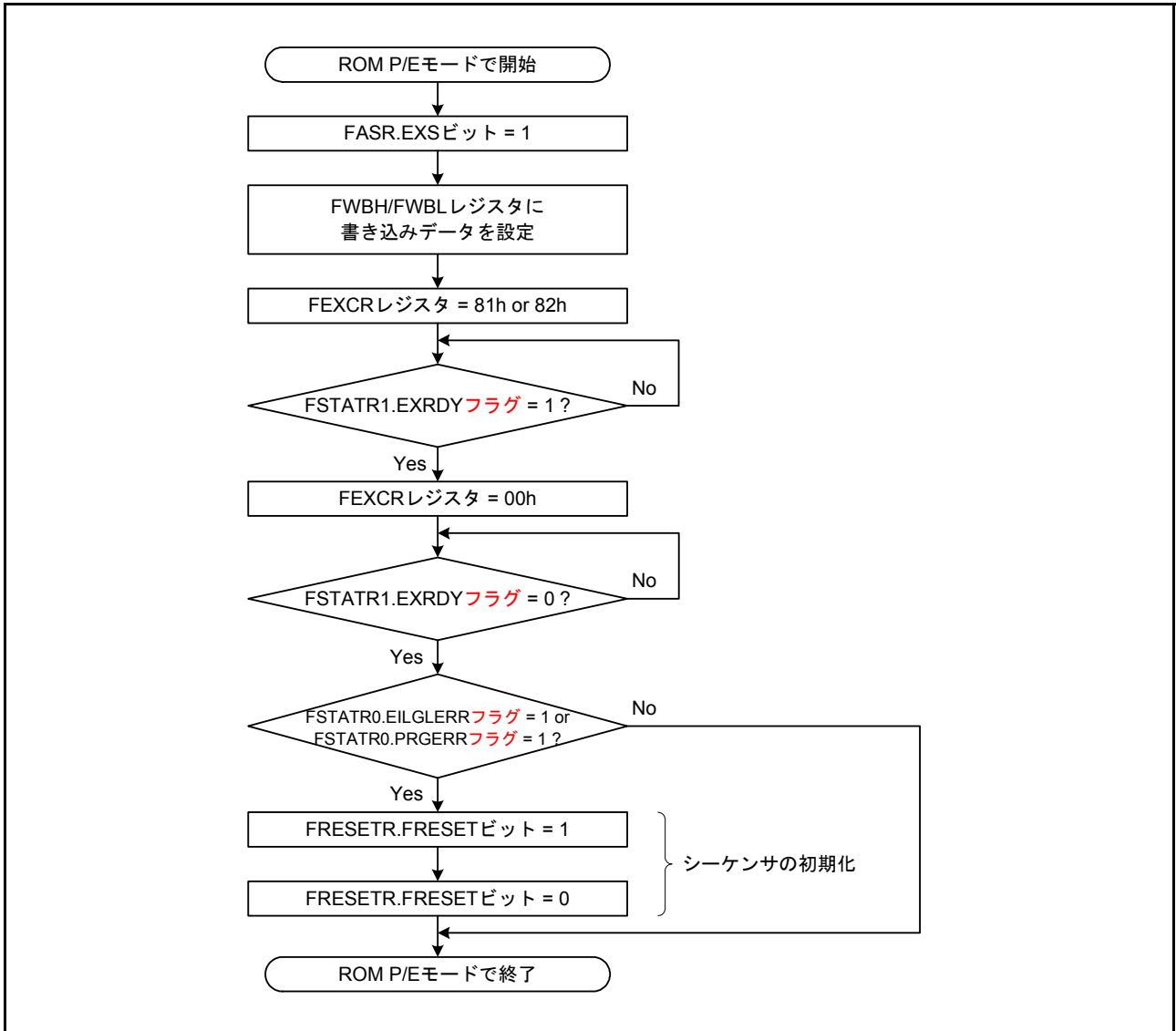


図31.10 スタートアップ領域情報プログラムコマンド/アクセスウィンドウ情報プログラムコマンドの発行フロー

以上